



No.967

2222

STK8250

厚膜混成集積回路
50W min AF パワーアンプ出力段 (2電源)
類似 A バイアス回路内蔵



- 特長
- ・ B クラスアンプ不可避のスイッチングひずみをゼロとしている。
 - ・ パワー段とバイアスコントロール回路 および 温度補償回路は 熱結合の良好にして組み込まれているため サーミスタ等の複雑な温度補正は必要なく 熱的に安定動作する。
 - ・ バイアス電流の設定を外部にて行なうことにより 最適な条件設定ができる。

最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

最大電源電圧	$V_{CC\ max}$		unit
熱抵抗	θ_{j-c}	理想放熱状態	$1.8\ ^\circ\text{C/W}$
コレクタ電流	I_C		5 A
接合部温度	T_j		150 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}		-30 ~ +105 $^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	t_b	$V_{CC} = \pm 38\text{V}^{\ast\ast}$, $f = 50\text{kHz}$, $P_O = 50\text{W}$, $R_L = 8\Omega$	2 sec

推奨動作条件 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

推奨電源電圧	V_{CC}		unit
負荷抵抗	R_L		8 Ω

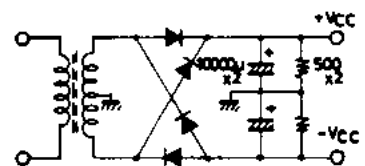
動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = \pm 38\text{V}$, $R_L = 8\Omega$, $R_g = 600\Omega$, $V_G = 26\text{dB}$, 指定測定回路 (応用回路例に準ずる) において。

		min	typ	max	unit
無信号電流	I_{CCO}			80	mA
出力電力	P_O		50		W
全帯調波ひずみ率	THD			0.01	%

注: $V_{CC} = \pm 43\text{V}^{\ast\ast}$
 THD = 0.01%, $f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$
 $P_O = 1.0 \sim 50\text{W}$, $f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$

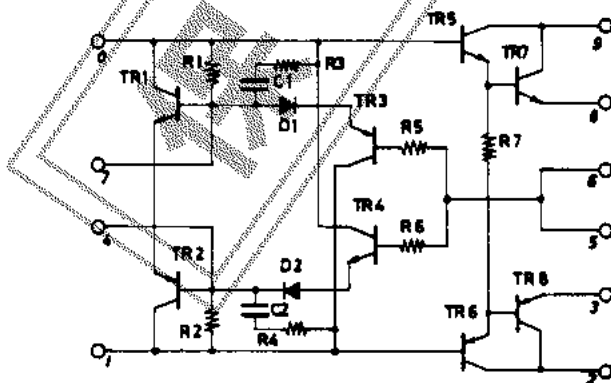
※: 負荷短絡許容時間は 右図の指定トランス電源を使用する。

※※: 指定回路 VR1 (30k Ω) 抵抗値最大とする。

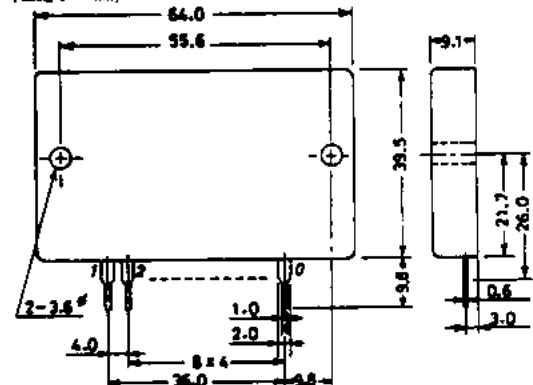


指定トランス電源
(タンゴMG-200相当)

等価回路



外形図 4006
(unit: mm)



※ これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。

